

SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

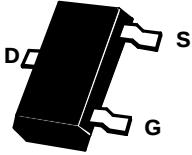
ISSUE 3 - JANUARY 1996

FEATURES

- * 60Volt V_{DS}
- * $R_{DS(ON)} = 5\Omega$

PARTMARKING DETAIL – MV

BS170F



SOT23

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	0.15	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	3	A
Gate Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	330	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j: T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60	90		V	$I_D=100\mu A$, $V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8		3	V	$I_D=1mA$, $V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}			10	nA	$V_{GS}=15V$, $V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}			0.5	μA	$V_{DS}=25V$, $V_{GS}=0V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$			5	Ω	$V_{GS}=10V$, $I_D=200mA$
Forward Transconductance (1)(2)	g_{fs}		200		mS	$V_{DS}=10V$, $I_D=200mA$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		60		pF	$V_{DS}=10V$, $V_{GS}=0V$, $f=1MHz$
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$			10	ns	$V_{DD} \approx -15V$, $I_D=600mA$
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$			10	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator
Spice parameter data is available upon request for this device

For typical characteristics graphs refer to ZVN3306F datasheet.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9